

# STPOWER SiC MOSFET

## 革新的な高電圧スイッチング



### 産業機器および車載アプリケーションで電力密度向上を実現する シリコン・カーバイド

STのSTPOWER SiC MOSFETは、ワイド・バンドギャップ材料の先進的かつ革新的な特性により、極めて低い単位面積あたりのオン抵抗と優れたスイッチング性能を兼ね備えており、より高効率でコンパクトな設計を実現します。

650VのSCTxN65G2\*製品ファミリに加えて、新しく1200VのSCTxN120G2\*製品ファミリをリリースしました。

これらの新しい製品ファミリは、200°Cという業界最高水準の温度定格を備え、パワー・エレクトロニクス・システムの熱設計を向上させます。

\* 品名に含まれるxは、任意の文字列を示すワイルド・カード

#### 特徴

- 超低スイッチング損失
- 高温での低電力損失
- より高い動作温度(最高200°C)
- リカバリ損失のないボディ・ダイオード
- 駆動が容易

#### 利点

- 小型化と電力密度の向上
- 受動部品のサイズ/コストの削減
- システム効率の向上
- 必要な冷却の軽減とヒートシンクの小型化

#### アプリケーション

- トラクション・インバータ
- EV充電ステーション
- 太陽光発電
- ファクトリ・オートメーション
- モータ・ドライブ
- データ・センターの電源
- OBC(車載充電器)、DC-DCコンバータ

## SiC MOSFETとシリコン・トランジスタの比較

表1は、STの新しい第2世代の650V対応55mΩ STPOWER SiC MOSFETであるSCTH35N65G2V-7と、同じ電圧定格およびオン抵抗成分を持つトレンチ・フィールドストップ (TFS) IGBTを比較しています。

STPOWER SiC MOSFETは、高温においても大幅に低いスイッチング損失を示します。そのため、非常に高いスイッチング周波数で動作可能で、受動部品のサイズ縮小により小型化を実現できます。さらに、STPOWER SiC MOSFETでは、温度変化に対する $E_{ON}$ と $E_{OFF}$ の変動が極めて小さくなります。例えば、温度が25°Cから175°Cに上昇した場合、STPOWER SiC MOSFETの $E_{OFF}$ は基本的に不変ですが、IGBTの $E_{OFF}$ は89%も増加します。図1に示すとおり、温度上昇に伴う抵抗の変動も極めて小さく、他社製品に比べて軽微な変化しか見られません。

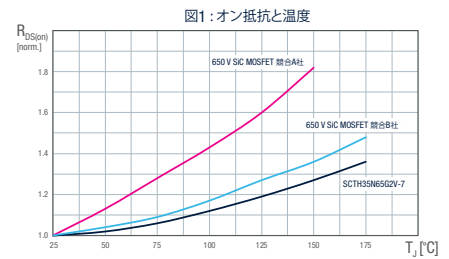


表1: スwitching損失の比較

デバイス	$V_{on}$ typ. (V) @ 25 °C, 20 A	$V_{on}$ typ. (V) @ 175 °C, 20 A	$E_{on}$ -typ (μJ) @ 20 A, 400 V 25 °C / 175 °C	$E_{off}$ -typ (μJ) @ 20 A, 400 V 25 °C / 175 °C	$E_{tot}$ 温度変化に対する 上昇	ダイ・サイズ
SCTH35N65G2V-7	1.1	1.48	100 / 100	35 / 35	温度に対して 軽微な変動	0.53
30 A, 650 V TFS IGBT	1.45	1.55	240 / 450	205 / 390	+89% (25°C~175°C)	1.00

$V_{ON}$ 測定は、 $V_{GS-SiC} = 18V$ 、 $V_{GE-IGBT} = 15V$

$E_{ON}$ スイッチング・エネルギーは、ダイオードの逆回復損失を含む

## STPOWER SiC MOSFET 650V Gen2 製品リスト

品名	$V_{DS}$ (V)	$R_{DS(ON)}$ Typ @ 25° C (Ω)	$I_b$ (A)	パッケージ			
				HiP247	HiP247-LL	HiP247-4LL	H2PAK-7L
				$T_J$ MAX= 200°C			$T_J$ MAX= 175°C
SCTx35N65G2V	650	0.55	45	X	X		
SCTWA35N65G2V-4*						X	
SCTH35N65G2V-7							X
SCTW35N65G2VAG*				X			
SCTH35N65G2V-7AG							X
SCTx90N65G2V	650	0.018	119	X	X		
SCTWA90N65G2V-4*						X	
SCTH90N65G2V-7							X
SCTW100N65G2AG				X			
SCTH100N65G2-7AG							X
		0.020	100				

\*データシートは2020年第4四半期中に公開予定

## STPOWER SiC MOSFET 1200V Gen2 製品リスト

品名	$V_{DS}$ (V)	$R_{DS(ON)}$ Typ @ 25° C (Ω)	$I_b$ (A)	パッケージ			
				HiP247	HiP247-LL	HiP247-4LL	H2PAK-7L
				$T_J$ MAX= 200°C			$T_J$ MAX= 175°C
SCTW40N120G2VAG	1200	0.075	33	X			
SCTW40N120G2V*		0.070	45	X			
SCTWA40N120G2V-4*						X	
SCTW60N120G2AG		0.045	60	X			
SCTW70N120G2V					X		
SCTWA70N120G2V-4*		0.025	95			X	

\*データシートは2020年第4四半期中に公開予定